

PNP 三重拡散形シリコントランジスタ

高速度高耐圧スイッチング用

PNP Silicon Triple Diffused Transistor  
High Speed High Voltage Switching

特 徴

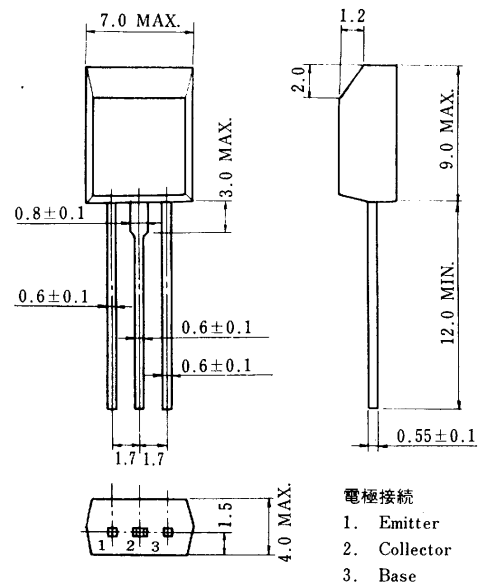
- 高耐圧です。  $V_{CEO} = -400\text{ V}$
- スイッチングスピードが速い。  $t_f < 0.7\text{ }\mu\text{s}$

絶対最大定格 ( $T_a = 25\text{ }^\circ\text{C}$ )

項 目	略 号	定 格	単 位
コレクタ・ベース間電圧	$V_{CBO}$	-400	V
コレクタ・エミッタ間電圧	$V_{CEO}$	-400	V
エミッタ・ベース間電圧	$V_{EBO}$	-7	V
コレクタ電流(直 流)	$I_{C(DC)}$	-2.0	A
コレクタ電流(パルス)	$I_{C(pulse)}$ *	-4.0	A
全 損 失	$P_T$	1.0	W
ジャンクション温度	$T_j$	150	$^\circ\text{C}$
保 存 温 度	$T_{stg}$	-55 ~ +150	$^\circ\text{C}$

\*  $PW \leq 10\text{ ms}$ , Duty Cycle  $\leq 50\%$

外形図 (単位: mm)



電気的特性 ( $T_a = 25\text{ }^\circ\text{C}$ )

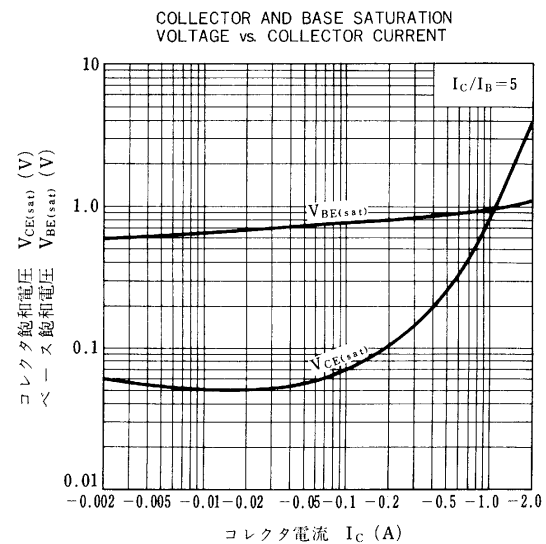
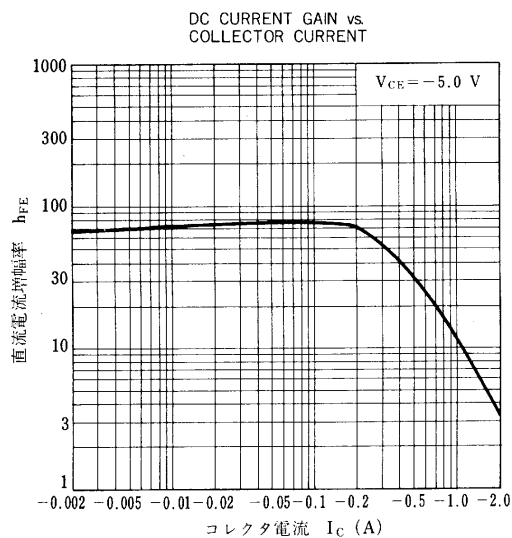
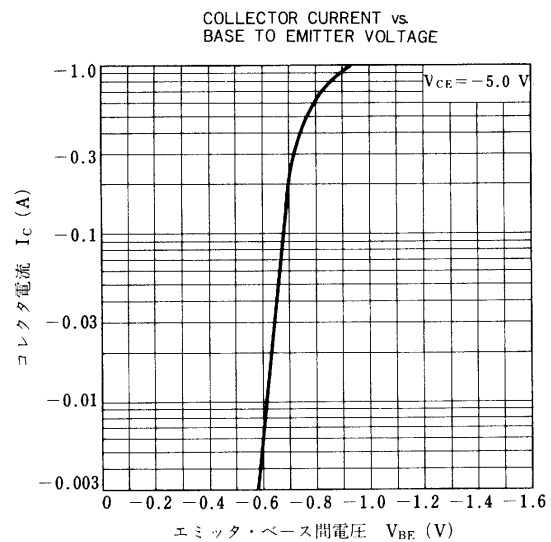
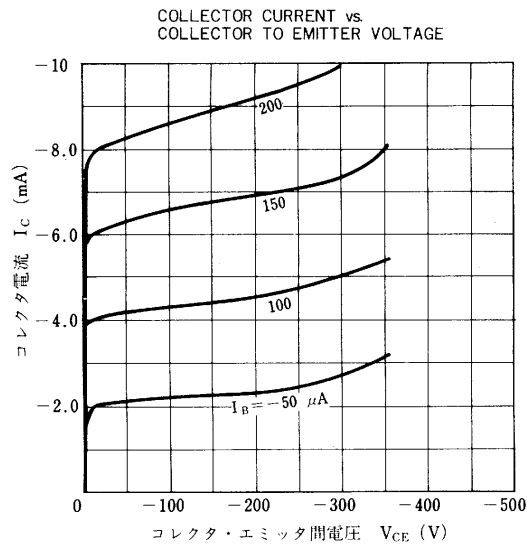
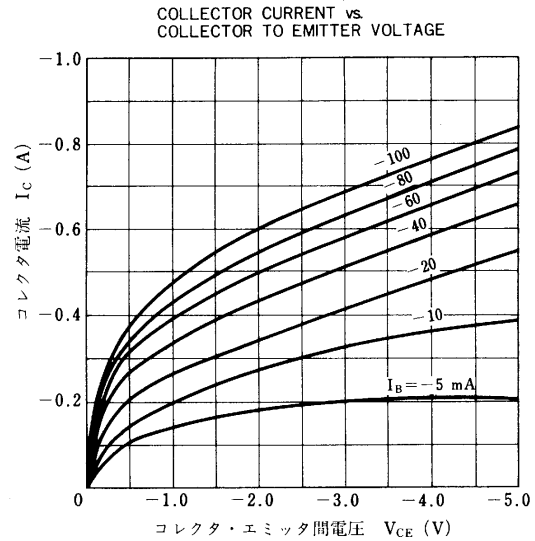
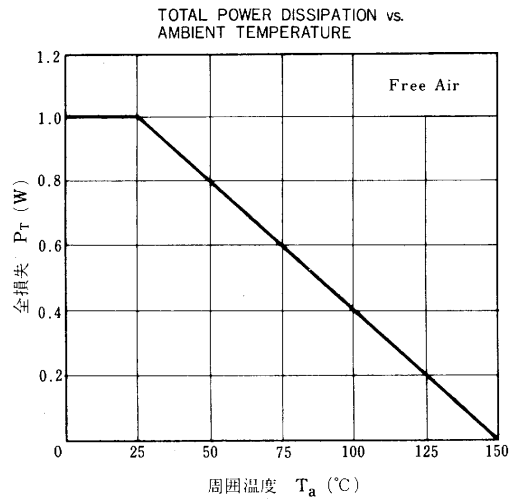
項 目	略 号	条 件	MIN.	TYP.	MAX.	単 位
コレクタしや断電流	$I_{CBO}$	$V_{CB} = -400\text{ V}$ , $I_E = 0$			-10	$\mu\text{A}$
エミッタしや断電流	$I_{EBO}$	$V_{EB} = -5.0\text{ V}$ , $I_C = 0$			-10	$\mu\text{A}$
直 流 電 流 増 幅 率	$h_{FE1}$ *	$V_{CE} = -5.0\text{ V}$ , $I_C = -0.1\text{ A}$	40	60	120	—
直 流 電 流 増 幅 率	$h_{FE2}$ *	$V_{CE} = -5.0\text{ V}$ , $I_C = -1.0\text{ A}$	6	22		—
コレクタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$ *	$I_C = -0.5\text{ A}$ , $I_B = -0.1\text{ A}$		-0.25	-0.5	V
ベース飽和電圧	$V_{BE(sat)}$ *	$I_C = -0.5\text{ A}$ , $I_B = -0.1\text{ A}$		-0.85	-1.2	V
コレクタ容量	$C_{ob}$	$V_{CB} = -10\text{ V}$ , $I_E = 0$ , $f = 1.0\text{ MHz}$		30	40	pF
利得帯域幅積	$f_T$	$V_{CE} = -10\text{ V}$ , $I_C = -0.1\text{ A}$	10	40		MHz
ターンオン時間	$t_{on}$	$I_C = -1.0\text{ A}$ , $R_L = 150\text{ }\Omega$		0.03	0.5	$\mu\text{s}$
蓄積時間	$t_{stg}$	$I_{B1} = -I_{B2} = -0.2\text{ A}$		1.4	2.0	$\mu\text{s}$
下降時間	$t_f$	$V_{CC} = -150\text{ V}$		0.1	0.7	$\mu\text{s}$

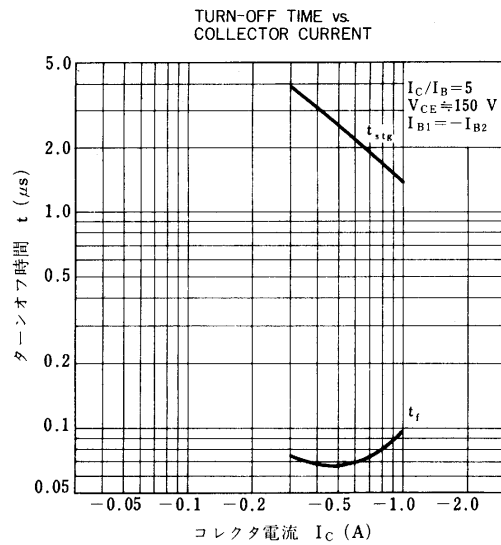
\* パルス測定  $PW \leq 350\text{ }\mu\text{s}$ , Duty Cycle  $\leq 2\%$

$h_{FE}$ 規格区分

捺 印	L	K
$h_{FE1}$	40 ~ 80	60 ~ 120

特性曲線 ( $T_a = 25^\circ\text{C}$ )





Downloaded from [DatasheetLib.com](https://www.datasheetlib.com) - datasheet search engine